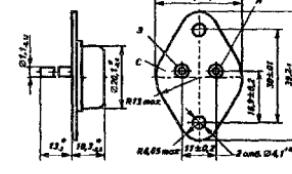


□ КП809А, КП809Б, КП809В, КП809Г, КП809Д, КП809Е



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные с каналом п-типа и с изолированным затвором, универсальные. Предназначены для применения в импульсных источниках вторичного электропитания с бестрансформаторным входом, в регуляторах, стабилизаторах, преобразователях с непрерывным импульсным управлением и в схемах управления электродвигателями. Выпускаются в металлическом корпусе с жесткими выводами и стеклянными изоляторами, тип корпуса КТ-9. Масса транзистора не более 16,1 г.

Электрические параметры

Крутинхарактеристики при $U_{ci} = 20$ В, $I_c = 3$ А, $t_i = 60$ мкс, $Q > 200$, $T = +25^\circ\text{C}$, не менее 1500 мА/В
Ток стока при $U_{ci} = 30$ В, $U_{zi} = 10$ В, $t_i = 60$ мкс, $Q > 200$, $T = +25^\circ\text{C}$, не менее:

КП809А 25 А
КП809Б 20 А

КП809В, КП809Г 15 А
КП809Д 10 А
КП809Е 8 А

Начальный ток стока при $U_{ci} = 20$ В, $U_{zi} = 0$ В, не более:

$T = +25^\circ\text{C}$ и $T = -10^\circ\text{C}$ 0,25 мА
 $T = +125^\circ\text{C}$ 1 мА

Остаточный ток стока при $U_{zi} = 0$ В, $T = +25^\circ\text{C}$, не более:

КП809А при $U_{ci} = 400$ В 1 мА
КП809Б при $U_{ci} = 500$ В 1 мА
КП809В при $U_{ci} = 600$ В 1 мА
КП809Г при $U_{ci} = 700$ В 1 мА
КП809Д при $U_{ci} = 800$ В 1 мА
КП809Е при $U_{ci} = 750$ В 1 мА

Ток утечки затвора при $U_{zc} = 20$ В, $U_{ci} = 0$ В, типовое значение 0,1 мА

Время нарастания при $U_{ci} = 200$ В, $U_{bx} = 20$ В, $R_g = 5$ Ом, $R_h = 100$ Ом 25*...50 нс

Время спада при $U_{ci} = 200$ В, $U_{bx} = 20$ В, $R_g = 5$ Ом, $R_h = 100$ Ом 45*...100 нс

Время задержки включения при $U_{ci} = 200$ В, $U_{bx} = 20$ В, $R_g = 5$ Ом, $R_h = 100$ Ом 25*...75 нс

Время задержки выключения при $U_{ci} = 200$ В, $U_{bx} = 20$ В, $R_g = 5$ Ом, $R_h = 100$ Ом 110*...220 нс

Сопротивление сток-исток при $U_{zi} = 20$ В, $I_c = 2$ А, $T = +25^\circ\text{C}$, не более:

КП809А 0,3 Ом
КП809Б 0,6 Ом
КП809В 1,2 Ом
КП809Г 1,5 Ом
КП809Д 1,8 Ом
КП809Е 2,5 Ом

Входная емкость при $U_{ci} = 25$ В, $U_{zi} = 0$ В, $f = 1$ МГц 2200*...3300 пФ

Проходная емкость при $U_{ci} = 25$ В, $U_{zi} = 0$ В, $f = 1$ МГц 170*...220 пФ

Выходная емкость при $U_{ci} = 25$ В, $U_{zi} = 0$ В, $f = 1$ МГц 400*...405 пФ

Пределные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сток-исток¹:

КП809А 400 В
КП809Б 500 В
КП809В 600 В
КП809Г 700 В
КП809Д 800 В
КП809Е 750 В

Постоянное напряжение затвор-исток ±20 В

Постоянный ток стока: КП809Б 9,6 А

Постоянная рассеиваемая мощность с теплоотводом при

$T = -10^\circ\text{C}$... $T_k = +25^\circ\text{C}$ 100 Вт

Температура кристалла +150°C

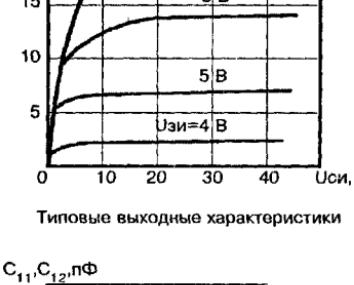
Температура окружающей среды (корпуса) ~10°C... $T_k = +125^\circ\text{C}$

¹ В диапазоне температур от +100°C до +125°C постоянное напряжение сток-исток снижается линейно:

для КП809А, КП809Б до 300 В,

для КП809В до 450 В,

для КП809Г, КП809Д, КП809Е до 600 В.



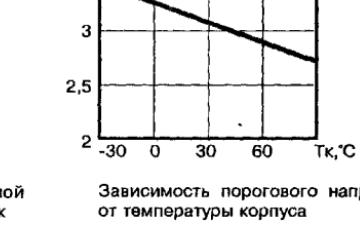
Типовые выходные характеристики



Зависимость крутизны характеристики от тока стока

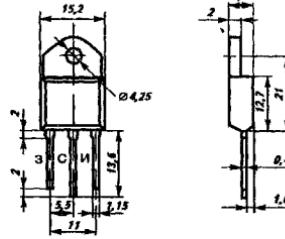


Зависимость входной и выходной емкостей от напряжения сток-исток



Зависимость порогового напряжения от температуры корпуса

□ КП809А1, КП809Б1, КП809В1, КП809Г1, КП809Д1, КП809Е1



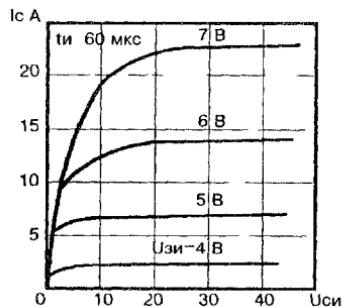
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные с каналом п-типа и с изолированным затвором, универсальные. Предназначены для применения в импульсных источниках вторичного питания с бестрансформаторным входом, в регуляторах, стабилизаторах, преобразователях с непрерывным импульсным управлением и в схемах управления электродвигателями. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами, тип корпуса КТ-43. Масса транзистора не более 5 г.

Электрические параметры

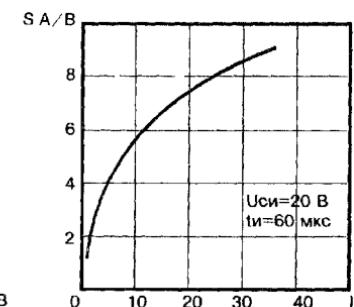
Крутизна характеристики при $U_{ci} = 20$ В, $I_c = 3$ А, $t_i = 60$ мкс, $Q > 200$, $T = +25^\circ\text{C}$, не менее	1500 мА/В
Ток стока при $U_{ci} = 30$ В, $U_{zi} = 10$ В, $t_i = 60$ мкс, $Q > 200$, $T = +25^\circ\text{C}$, не менее	
КП809А1	25 А
КП809Б1	20 А
КП809В1, КП809Г1	15 А
КП809Д1	10 А
КП809Е1	8 А
Начальный ток стока при $U_{ci} = 20$ В, $U_{zi} = 0$ В, не более $T = +25^\circ\text{C}$ и $T = -10^\circ\text{C}$	0,25 мА
$T = +125^\circ\text{C}$	1 мА
Остаточный ток стока при $U_{zi} = 0$ В, $T = +25^\circ\text{C}$, не более	
КП809А1 при $U_{ci} = 400$ В	1 мА
КП809Б1 при $U_{ci} = 500$ В	1 мА
КП809В1 при $U_{ci} = 600$ В	1 мА
КП809Г1 при $U_{ci} = 700$ В	1 мА
КП809Д1 при $U_{ci} = 800$ В	1 мА
КП809Е1 при $U_{ci} = 750$ В	1 мА
Ток утечки затвора при $U_{ci} = 0$ В, $U_{zi} = 20$ В, типовое значение	0,1 мА
Время нарастания при $U_{ci} = 200$ В, $U_{bx} = 20$ В, $R_g = 5$ Ом, $R_h = 100$ Ом	25* 50 нс
Время спада при $U_{ci} = 200$ В, $U_{bx} = 20$ В, $R_g = 5$ Ом, $R_h = 100$ Ом	45* 100 нс
Время задержки включения при $U_{ci} = 200$ В, $U_{bx} = 20$ В, $R_g = 5$ Ом, $R_h = 100$ Ом	25* 75 нс
Время задержки выключения при $U_{ci} = 200$ В, $U_{bx} = 20$ В, $R_g = 5$ Ом, $R_h = 100$ Ом	110* 220 нс
Сопротивление сток исток при $U_{zi} = 20$ В, $I_c = 2$ А, $T = +25^\circ\text{C}$, не более	
КП809А1	0,3 Ом
КП809Б1	0,6 Ом
КП809В1	1,2 Ом
КП809Г1	1,5 Ом
КП809Д1	1,8 Ом
КП809Е1	2,5 Ом
Входная емкость при $U_{ci} = 25$ В, $U_{zi} = 0$ В, $f = 1$ МГц	2200* 3300 пФ
Проходная емкость при $U_{ci} = 25$ В, $U_{zi} = 0$ В, $f = 1$ МГц	170* 220 пФ
Выходная емкость при $U_{ci} = 25$ В, $U_{zi} = 0$ В, $f = 1$ МГц	400* 405 пФ

Пределевые эксплуатационные данные

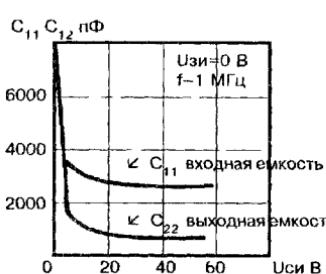
Постоянное напряжение сток исток	
КП809А1	400 В
КП809Б1	500 В
КП809В1	600 В
КП809Г1	700 В
КП809Д1	800 В
КП809Е1	750 В
Постоянное напряжение затвор исток	± 20 В
Постоянный ток стока	
КП809Б1	9,6 А
Постоянная рассеиваемая мощность с теплоотводом при $T = -10^\circ\text{C}$ $T_k = +25^\circ\text{C}$	50 Вт
Температура кристалла	+150°C
Температура окружающей среды (корпуса)	-10°C $T_k = +70^\circ\text{C}$



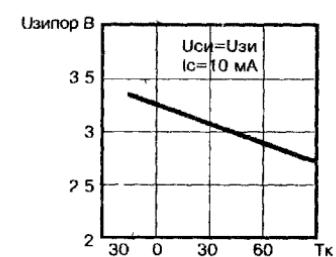
Типовые выходные характеристики



Зависимость крутизны характеристики от тока стока



Зависимость входной и выходной емкостей от напряжения сток исток



Зависимость порогового напряжения от температуры корпуса